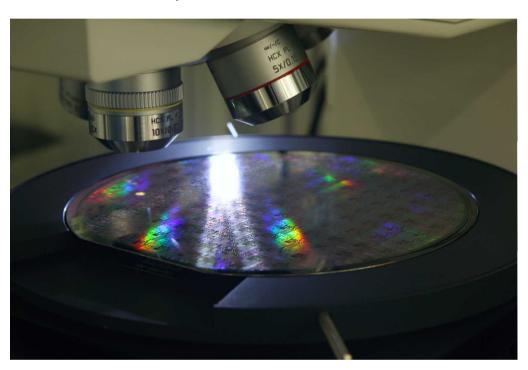
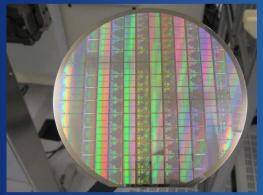


ИЗГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ «ФАУНДРИ» ПЛАСТИН С КРИСТАЛЛАМИ ЗАКАЗАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ КМОП КНИ 0,35 МКМ



МИКРОЭЛЕКТРОНИКА НИИИС







ИСХОДНЫЕ СТРУКТУРЫ:

КНИ 150 мм с толщиной приборного слоя 0,2 мкм, захороненного окисла 0,2 мкм

ИЗГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ «ФАУНДРИ» ПЛАСТИН С КРИСТАЛЛАМИ ЗАКАЗАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ КМОП КНИ 0.35 МКМ

Минимальные проектные нормы, мкм			0,35
Количество уровней поликремния			1
Количество уровней металлизации			4
Количество карманов			2
Количество скрытых слоев			0
Количество подзатворных диэлектриков			1
n-канальный транзистор	МОП	Пороговое напряжение, В	(0,5 ÷ 0,7)
		Напряжение пробоя сток-исток, В	Не менее 7
		Ток насыщения, мкА/мкм	(375 ÷ 520)
		Ток утечки, А/мкм	Не более 1×10 ⁻¹⁰ при напряжении на стоке 3,3 В
р-канальный транзистор	МОП	Пороговое напряжение, В	Минус (0,5 ÷ 0,7)
		Напряжение пробоя сток-исток, В	Не более минус 7
		Ток насыщения, мкА/мкм	Минус (200 ÷ 330)
		Ток утечки, А/мкм	Не менее минус 1×10 ⁻¹⁰ при напряжении на стоке минус 3,3 В
Диапазон рабочих температур, °С			От минус 60 до 125

КОНТАКТЫ:

ГРУППА ПРОДВИЖЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ:

Телефон: +7(831) 469-56-51

+7(930) -2902-100 E-mail: info@niiis-micro.ru



www.niiis-micro.ru

Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е.Седакова» Группа продвижения и реализации изделий микроэлектроники

603951, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Тропинина 47; Телефон: +7(831) 466-14-80; Факс: +7(831) 466-87-52, +7(831) 466-67-69